

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 17 年 12 月 22 日 (2005.12.22)

【公開番号】特開 2000-150678 (P2000-150678A)

【公開日】平成 12 年 5 月 30 日 (2000.5.30)

【出願番号】特願 平 10-319415

【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 21/8247

H 0 1 L 29/788

H 0 1 L 29/792

H 0 1 L 21/28

H 0 1 L 21/3065

H 0 1 L 27/115

【F I】

H 0 1 L 29/78 3 7 1

H 0 1 L 21/28 F

H 0 1 L 21/302 J

H 0 1 L 27/10 4 3 4

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 11 月 4 日 (2005.11.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 17

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 17】 半導体基板の主表面に設けられた第 1 ゲート絶縁膜と、
その上に形成された第 1 ゲート電極と、
前記第 1 ゲート電極の上に第 2 ゲート絶縁膜を介して形成された第 2 ゲート電極と、
前記第 2 ゲート電極の側壁に形成された保護膜とを備えている不揮発性半導体記憶装置

。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 18

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 18】 半導体基板の主表面に設けられた第 1 ゲート絶縁膜と、
その上に形成された第 1 ゲート電極と、
前記第 1 ゲート電極の上に第 2 ゲート絶縁膜を介して形成された第 2 ゲート電極と、
前記第 1 ゲート電極の側壁に接する絶縁膜と第 1 ゲート絶縁膜とが形成する段差側壁に
、多結晶シリコンが絶縁体化されたシリコン化合物とを有する不揮発性半導体記憶装置。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 19

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 19】 半導体基板の上に、第 1 ゲート絶縁膜を介して第 1 ゲート層がエッチングされることにより形成された第 1 ゲート電極と、
その第 1 ゲート電極の上に、第 2 ゲート絶縁膜を介して第 2 ゲート層がエッチングされ

ることにより形成された第２ゲート電極とを備えた不揮発性半導体記憶装置であって、

前記第１ゲート電極の側壁が接する絶縁膜と前記第１ゲート絶縁膜とによって形成される角度が、前記第１ゲート電極の側壁に沿って延びる方向に直交する断面で、前記第１ゲート電極側に対して 90° を超え、前記第１ゲート電極の側壁が接する絶縁膜の両側壁の各々には、前記第１ゲート電極の幅が上方ほど広くなるようにテーパがつけられている不揮発性半導体記憶装置。